

3. 17flash 读写

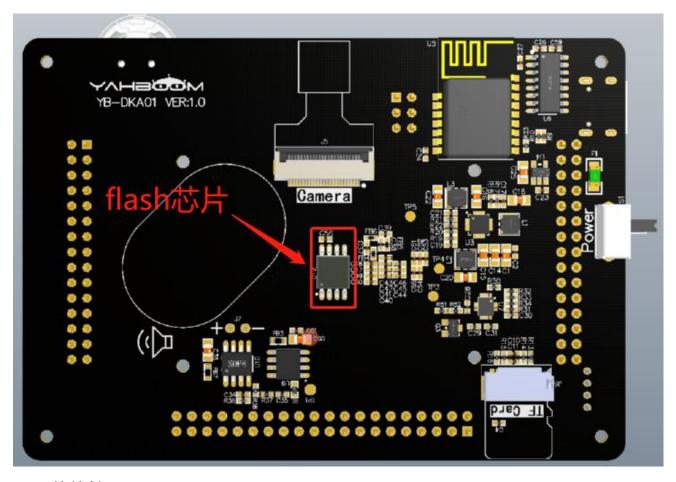
一、实验目的

本节课主要学习 K210 读写 flash 芯片的功能。

二、实验准备

1. 实验元件

flash 芯片 GD25LQ128C。



2. 元件特性

flash 芯片 GD25LQ128C 是通过 SPI 串行闪存的芯片,具有 128M-bit (16 兆字节 MByte)空间,能够储存声音、文本和数据等,设备运行电源为 $2.7V^{\sim}3.6V$,低功耗模式电流低至 1uA。

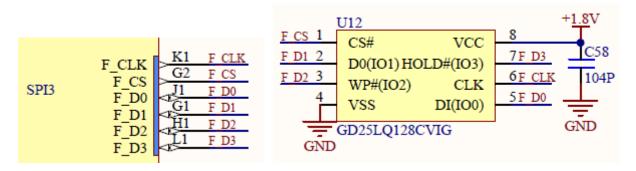


写数据,每次向 GD25LQ128C 写入数据都需要按照页或者扇区或者簇为单位进行,一页为 256 个字节,一个扇区为 4K 个字节(16 页),一次最多写一页,也就是一次最多写 256 个字节,如果超过一页数据长度,则分多次完成。

读数据,可以从任何地址读出。

擦除数据,最小单位为一个扇区,也可以直接擦除整个 flash 芯片。

3. 硬件连接



4. SDK 中对应 API 功能

flash 使用的是 SPI 的通讯方式,所以对应的头文件是 spi. h,而由于 flash 芯片的特殊性,kendryte 官方已经写好了 flash 的库,对应的头文件是 w25qxx. h。为用户提供以下接口:

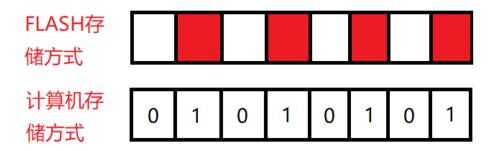
- w25qxx init: 初始化 flash 芯片,主要是设置 SPI 的设备、通道和速率等。
- w25qxx read id: 读取 flash 的 ID。
- w25gxx write data: 向 flash 写入数据。
- w25qxx read data: 从 flash 读取数据。

三、实验原理

FLASH 芯片是应用非常广泛的存储材料,与之对应的是 RAM 芯片,区别在于 FLASH 芯片断电后数据可以保存,而 RAM 芯片断电后数据不会保存。那么 FLASH 是如何工作的呢? 计算机的储存方式是二进制,也就是 0 和 1,在二进制中,0 和 1 可以组成任何数。FLASH 芯片对 0 和 1 的处理方式是用物质填充,1 则填充,



0则不填充,如下图所示,这样就算断电之后,物质的性质也不会因为没有电而改变,所以再次读取数据的时候数据依然不变,这样就可以做到断电保存。



四、实验过程

1. 设置系统时钟 PLL0 频率。

```
/* 设置新PLL0频率 */
sysctl_pll_set_freq(SYSCTL_PLL0, 800000000);
uarths_init();
```

2. 使用的是 spi3 的 CSO 通道初始化 flash, 读取 flash 的 ID 进行对比,如果发现不对则对打印错误信息,并且返回 0。

```
int flash_init(void)
{
    uint8_t manuf_id, device_id;
    uint8_t spi_index = 3, spi_ss = 0;
    printf("flash init \n");

    w25qxx_init(spi_index, spi_ss, 60000000);
    /* 读取flash的ID */
    w25qxx_read_id(&manuf_id, &device_id);
    printf("manuf_id:0x%02x, device_id:0x%02x\n", manuf_id, device_id);
    if ((manuf_id != 0xEF && manuf_id != 0xC8) || (device_id != 0x17 && device_id != 0x16))
    {
        /* flash初始化失败 */
        printf("w25qxx_read_id error\n");
        printf("manuf_id:0x%02x, device_id:0x%02x\n", manuf_id, device_id);
        return 0;
    }
    else
    {
        return 1;
    }
}
```



3. 初始化数据, write_buf 为写入的数据, 赋予初始值, read_buf 为读取的数据, 清空所有值为 0。

```
/* 给缓存写入的数据赋值 */
for (int i = 0; i < BUF_LENGTH; i++)
    write_buf[i] = (uint8_t)(i);

/* 清空读取的缓存数据 */
for(int i = 0; i < BUF_LENGTH; i++)
    read_buf[i] = 0;
```

4. 先把缓存的数据 write_buf 写入到 FLASH 里面,并且打印写入总共花费的时间。

```
void flash_write_data(uint8_t *data_buf, uint32_t length)
{
    uint64_t start = sysctl_get_time_us();
    /* flash写入数据 */
    w25qxx_write_data(DATA_ADDRESS, data_buf, length);
    uint64_t stop = sysctl_get_time_us();
    /* 打印写入数据的时间(us) */
    printf("write data finish:%ld us\n", (stop - start));
}
```

5. 再将数据从 FLASH 芯片中读取出来, 打印读取的时间。

```
void flash_read_data(uint8_t *data_buf, uint32_t length)
{
    uint64_t start = sysctl_get_time_us();
    /* flash读取数据 */
    w25qxx_read_data(DATA_ADDRESS, data_buf, length);
    uint64_t stop = sysctl_get_time_us();
    /* 打印读取数据的时间(us) */
    printf("read data finish:%ld us\n", (stop - start));
}
```

6. 最后是对比 write_buf 和 read_buf 的差异,如果有不同则打印错误信息并退出,如果相同则提示 OK。



```
printf("flash start write data\n");

/* flash写入数据 */
flashwrite_data(write_buf, BUF_LENGTH);

/*flash读取数据*/
flash_read_data(read_buf, BUF_LENGTH);

/* 比较数据,如果有不同则打印错误信息 */
for (int i = 0; i < BUF_LENGTH; i++)
{

    if (read_buf[i] != write_buf[i])
    {

        printf("flash read error\n");
        return 0;
     }
}

printf("spi3 flash master test ok\n");
while (1)
    ;
return 0;
```

7. 编译调试,烧录运行

把本课程资料中的 flash 复制到 SDK 中的 src 目录下,然后进入 build 目录,运行以下命令编译。

```
cmake .. -DPROJ=flash -G "MinGW Makefiles" make
```

```
[ 95%] Building C object CMakeFiles/flash.dir/src/flash/main.c.obj
[ 97%] Linking C executable flash
Generating .bin file ...
[100%] Built target flash
PS C:\K210\SDK\kendryte-standalone-sdk-develop\build> [
```

编译完成后,在 build 文件夹下会生成 flash. bin 文件。

使用 type-C 数据线连接电脑与 K210 开发板,打开 kflash,选择对应的设备,再将程序固件烧录到 K210 开发板上。



五、实验现象

烧录完成固件后,系统会弹出一个终端界面,如果没有弹出终端界面的可以 打开串口助手显示调试内容。

```
C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\tmpC06C.tmp

flash init

manuf_id:0xc8, device_id:0x17

flash start write data

write data finish:293830 us

read data finish:1656 us

spi3 flash master test ok
```

打开电脑的串口助手,选择对应的 K210 开发板对应的串口号,波特率设置为115200,然后点击打开串口助手。注意还需要设置一下串口助手的 DTR 和 RTS。在串口助手底部此时的 4. DTR 和 7. RTS 默认是红色的,点击 4. DTR 和 7. RTS,都设置为绿色,然后按一下 K210 开发板的复位键。



可以看到串口助手打印打印出 flash 初始化以及写入和读取的时间,当看到最后是"spi3 flash master test ok"则表示读写成功,如果看到的是"flash read error"则表示读写失败。





六、实验总结

- 1. GD25LQ128C 的一款存储空间为 16MB 的 FLASH 芯片,总共有 4096 个扇区,每个扇区有 16 页,每页是 256 字节。
- 2. FLASH 是能够断电保存数据的一种储存方式。
- 3. FLASH 的擦除最小单位为扇区,也就是 4K。

附: API

对应的头文件 wdt.h

w25qxx_init

描述

初始化 flash 芯片,设置 SPI 设备号、通道号和速率。

函数原型

w25qxx_status_t w25qxx_init(uint8_t spi_index, uint8_t spi_ss, uint32_t rate)

参数

参数名称	描述	输入输出
spi_index	SPI 设备号	输入
spi_ss	CS 片选	输入
rate	通讯速率	输入

返回值

返回 flash 的状态。

w25qxx_read_id

描述



读取 flash 的 ID 号。

函数原型

w25qxx_status_t w25qxx_read_id(uint8_t *manuf_id, uint8_t *device_id)

参数

参数名称	描述	输入输出
manuf_id	工厂ID	输出
device_id	设备 ID	输出

返回值

返回 flash 的状态。

w25qxx_write_data

描述

向 flash 写入数据。

函数原型

w25qxx_status_t w25qxx_write_data(uint32_t addr, uint8_t *data_buf, uint32_t
length)

参数

参数名称	描述	输入输出
addr	Flash 地址	输入
data_buf	写入的数据	输入
length	数据长度	输入

返回值

返回 flash 的状态。

w25qxx_read_data

描述

从 flash 读取数据。



函数原型

w25qxx_status_t w25qxx_read_data(uint32_t addr, uint8_t *data_buf, uint32_t
length)

参数

参数名称	描述	输入输出
addr	Flash 地址	输入
data_buf	读取的数据	输出
length	数据长度	输入

返回值

返回 flash 的状态。

数据类型

相关数据类型、数据结构定义如下:

- w25qxx_status_t
- w25qxx_read_t

w25qxx_status_t

描述

flash 芯片状态。

定义

```
typedef enum _w25qxx_status
{
     W25QXX_OK = 0,
     W25QXX_BUSY,
     W25QXX_ERROR,
} w25qxx_status_t;
```

成员



成员名称	描述
W25QXX_OK	flash OK
W25QXX_BUSY	flash 忙碌
W25QXX_ERROR	flash 出错

w25qxx_read_t

描述

spi 读取 flash 的方式。

定义

```
typedef enum _w25qxx_read
{
    W25QXX_STANDARD = 0,
    W25QXX_STANDARD_FAST,
    W25QXX_DUAL,
    W25QXX_DUAL_FAST,
    W25QXX_QUAD,
    W25QXX_QUAD_FAST,
} w25qxx_read_t;
```

成员

成员名称	描述
W25QXX_STANDARD	标准模式
W25QXX_STANDARD_FAST	标准快速模式
W25QXX_DUAL	双线模式
W25QXX_DUAL_FAST	双线快速模式
W25QXX_QUAD	四线模式
W25QXX_QUAD_FAST	四线快速模块